

ТРАНЗИСТОРЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ
HIGH-POWER MEDIUM-FREQUENCY TRANSISTORS

KT837A-KT837Ф

Транзисторы KT837A-KT837Ж, KT837И-KT837Н, KT837П-KT837Ф предназначены для работы в схемах переключения, выходных каскадах низкочастотных усилителей, преобразователях и стабилизаторах постоянного напряжения и другой аппаратуре широкого применения.

Si-p-n-p-ED

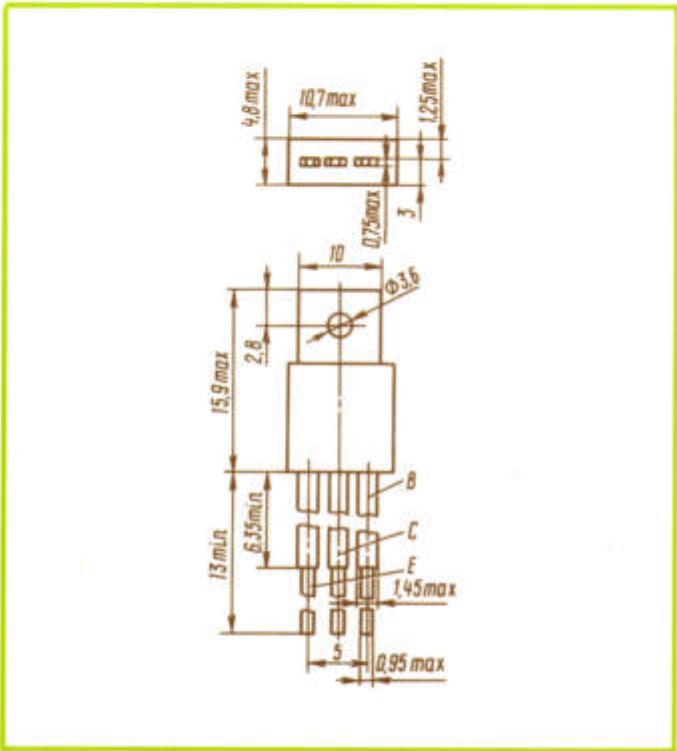
The KT837A-KT837Ж, KT837И-KT837Н, KT837П-KT837Ф transistors are designed for use in switching circuits, the output stages of frequency amplifiers, converters, DC voltage regulators and other circuits in a wide range of applications.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДАННЫЕ $t_{case} = -45...+85^{\circ}C$
MAXIMUM RATINGS

$U_{CB\ max.}, V:$	
KT837A-B, Л-Н	80
KT837Г-Е, П-С	60
KT837Ж-К, Т-Ф	45
$U_{CE\ max.} (R_{EB} = 50\ \Omega), V:$	
KT837A-B, Л-Н	70
KT837Г-Е, П-С	55
KT837Ж-К, Т-Ф	40
$U_{EB\ max.}, V:$	
KT837A-К	15
KT837Л-Ф	5
$I_C\ max., A$	7,5
$I_B\ max., A$	1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	КТ837									Режимы Conditions
	А, Л, Г, П, Ж, Т			Б, М, Д, Р, И, У,			В, Н, Е, С, К, Ф			
1	2			3			4			5
h_{21E}	10–40			20–80			50–150			$U_{CE} = 5\text{ В}$ $I_C = 2\text{ А}$
$I_{CBO}, \text{ мА}$	$\leq 0,15$									$I_{CB} = U_{CB \text{ max.}}$
$I_{CER}, \text{ мА}$	≤ 10									$U_{CB} = U_{CB \text{ max.}}$ $R_{EB} = 50\ \Omega$
$I_{CEO}, \text{ мА}$	≤ 10									$U_{CB} = U_{CB \text{ max.}}$
$I_{EBO}, \text{ мА}$	$\leq 0,3$									$U_{EB} = 15\text{ В}$
$U_{CE \text{ sat}}, \text{ В}$	2,5	0,9	0,5	2,5	0,9	0,5	2,5	0,9	0,5	$I_C = 3\text{ А}$ $I_B = 0,37\text{ А}$
$U_{BE \text{ sat}}, \text{ В}$	$\leq 1,5$									$I_C = 2\text{ А}$ $I_B = 0,5\text{ А}$



$P_C\ max. (t_{case} \leq 25^{\circ}C), W:$	
с теплоотводом*	
heat sink*	30
без теплоотвода	
free air	1
$t_j\ max.$	100°C
*При $t_{case} > 25^{\circ}C \Rightarrow P_{C\ max.} = \frac{125 - t_{case}}{4}$	

KT837A-KT837Ф

